

2SD1088

シリコンNPN三種拡散形トランジスタ(ダーリントン接続)

- イグナイタ用
- 高電圧スイッチング用

通信工業用

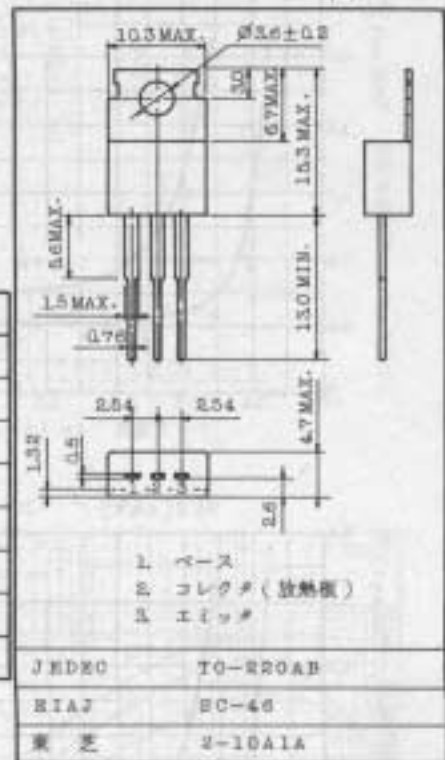
単位: mm

特長

- 直流電流増幅率が高い。
: $h_{FE} = 2000$ (最小) ($V_{CE} = 2V, I_C = 2A$)

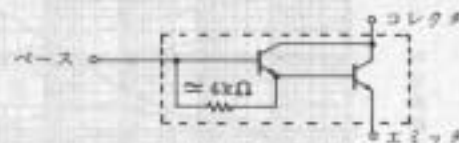
最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	300	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	250	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	6	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	30	W
結合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリは A075 を適用

等価回路



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 300V, I_B = 0$	-	-	0.5	mA
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	-	-	0.5	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 0.5A, L = 40mH$	250	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 2A$	2000	-	-	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 4A$	200	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 4A, I_B = 0.04A$	-	-	2.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 4A, I_B = 0.04A$	-	-	2.5	V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 50V, I_B = 0, f = 1MHz$	-	35	-	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	-	1	-	ns
	蓄積時間	t_{stg}	-	8	-	
	下降時間	t_f	-	5	-	

